(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 株は用2002 --- 16722

特/男2003-167328 (P2003-167328A) (43)公開日 平成15年6月13日(2003.6.13)

(51) Int.Cl. <sup>2</sup>		識別们号	FΙ		;	r-7I-}*(参考)
G03F	1/14		C 0 3 F	1/14	K	2H095
	7/20	521		7/20	521	5 F 0 4 6
H01L	21/027		H01L	21/30	502P	
					516F	

## 審査請求 未請求 請求項の数26 OL (全 15 頁)

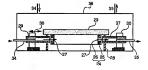
(72)発明者 加茂野 隆					
(22) 前綱日 平成13年12月4日(2001.12.4) 東京都大田区下丸子3 『目30番2年 (77)発明者 加茂庁 権 東京都大田区下丸子3 『目30番2年 ノン様式会社内 (74)代理人 107076728 弁理士 大塚 成新 (外3 名)	(21)出顧番号	特顧2001-370352(P2001-370352)	(71)出頭人 000001007		
(72)発明者 加茂野 隆 東京都太田区下丸子3 『目30番2年 / 八林式会社内 (74)代理人 100076928 中理士 大塚 遠鄭 (外3名)			キヤノン株式会社		
東京都大田区下丸子 3 『国30番 2 # ノン様式会社内 (74)代理人 10007642/8 弁理士 大塚 成彰 (外3名)	(22) 出版日	平成13年12月4日(2001, 12.4)	東京都大田区下丸子3 「目30番2号		
ノン株式会社内 (74)代理人 100076428 弁理士 大塚 康純 (外3名)			(72)発明者 加茂野 隆		
ノン株式会社内 (74)代理人 100076428 弁理士 大塚 康衡 (外3名)			東京都大田区下丸子3 『目30番2号 キヤ		
(74)代理人 1000761/28 弁理士 大塚 康衡 (分3名)					
弁理士 大塚 康衡 (外3名)					
F ターム(参考) 21095 BC38 BC39					
			F ターム(参考) 2H095 BC38 BC39		
5F046 AA22 DA27			5F046 AA22 DA27		

# (54) 【発明の名称】 デバイス製造関連装置、ガス置換方法及びデバイス製造方法

#### (57) 【要約】

【課題】ペリクル枠に不活性ガス供給部を近接させてペ リクル空間内に不活性ガスを供給する際におけるペリク ル枠の変形等を最小服に抑える。

「解決手段」レナクル支持台28上にベリクル付きレチ クル23を移動可能な状態で載置し、その後、ベリクル 枠25を挟むように、不活性グス供給第29及び不活性 ガス財活第37を影動し、ベリクル枠25を位置抜かさ をともに、ベリクル枠25を位置抜かさ をともに、ベリクル枠25では世外表情第29及 び不活性ガス株前第37を密着させる。この状態で、不 活性ガス供給第29からベリクル枠25両気孔27を 通してベリクル空間内に不活性ガス体制と、反対側に 設けられた通気孔27を通して不活性ガス排気部37に 不活性ガス株類372で通して不活性ガス排気部37に 不活性ガス様数する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ペリクル機をベリクル枠で支持したベリ クル付きレチクルを収容する空間を有するデバイス製造 関連装置であって、

前記ペリクル枠を所定の位置に位置決めする位置決め機構を備えることを特徴とする。

【請求項2】 請求項1に記載のデバイス製造関連装置であって.

前記ペリクル付きレチクルは、前記ペリクル枠に通気孔 を有し、

前記デバイス製造関連装置は、前記通気孔を通して、前 記ペリクル枠内の空間であるペリクル空間に不活性ガス を供給する不活性ガス供給部を更に備えることを特徴と

【請求項3】 請求項2に記載のデバイス製造関連装置であって、

前記位置決め機構は、前記不活性ガス供給部を移動させ ることにより前記ペリクル枠を位置決めすることを特徴 とする。

【請求項4】 請求項2に記載のデバイス製造関連装置 であって

前記位置決め機構は、前記不活性ガス供給部を位置決め の基準として前記ペリクル枠を位置決めすることを特徴 とする。

【請求項5】 請求項3又は請求項4に記載のデバイス 製造関連装置であって、

前記不活性ガス供給部は、その先端に弾性体を有し、 前記位置決め機構は、位置決め及び不活性ガスの供給の 際に、前記弾性体と前記ペリクル枠とを密着させること

を特徴とする。 【請求項6】 請求項5に記載のデバイス製造関連装置であって、

前記ペリクル膜の面に直交する方向についての前記弾性 体の幅が、前記ペリクル膜の面に直交する方向について の前記ペリクル枠の幅とほぼ等しいことを特徴とする。 【請求項7】 請求項3乃至請求項6のいずれか1項に 記載のデバイス製造限論を着であって。

前記位置決め機構は、位置決め及び不活性ガスの供給の 際に、前記不活性ガス供給部の先端で前記ペリクル枠を 押圧することを特徴とする。

【請求項8】 請求項7に記載のデバイス製造関連装置であって、

前記位置決め機構は、前記ペリクル枠に加わる力を検知 するセンサを有し、前記不活性ガス供給部の先端で前記 ペリクル枠を押圧・前記や活性ガス供給部の先端で前記 ペリクル枠を押圧する力を前記センサの出力に基づいて 制御することを特徴とする。

【請求項9】 請求項7又は請求項8に記載のデバイス 製造関連装置であって、

前記位置決め機構は、前記ペリクル膜の面に平行な方向に、前記不活性ガス供給部の先端で前記ペリクル枠を押

圧することを特徴とする。

【請求項10】 請求項1に記載のデバイス製造関連装 置であって、

前記ペリクル付きレチクルは、前記ペリクル枠に第1及 び第2の通気孔を有し、

前記デバイス製造関連装置は、

前記第1の通気孔を通して、前記ペリクル枠内の空間で あるペリクル空間に不活性ガスを供給する不活性ガス供 給部と、

前記第2の通気孔を通して、前記ペリクル空間内のガス を排気する不活性ガス排気部と、

を更に備えることを特徴とする。

【請求項11】 請求項10に記載のデバイス製造関連 装置であって

前記位置決め機構は、前記不活性ガス供給部及び前記不 活性ガス排気部の少なくとも一方を移動させることによ

り前記ペリクル枠を位置決めすることを特徴とする。 【請求項12】 請求項10に記載のデバイス製造関連 装置であって、

前記位置決め機構は、前記不活性ガス供給部又は前記不 活性ガス排気部を位置決め基準として前記ペリクル枠を 位置決めすることを特徴とする。

【請求項13】 請求項11又は請求項12に記載のデ バイス製造関連装置であって、

前記位置決め機構は、前記不活性ガス供給部及び前記不 活性ガス排気部によって前記ペリクル枠を挟むように、 前記不活性ガス供給部及び前記不活性ガス排気部の少な くとも一方を駆動して、前記ペリクル枠を位置決めする ことを特徴とする。

【請求項14】 請求項13に記載のデバイス製造関連 装置であって、

前記位置決め機構は、前記ペリクル枠に加わる力を検知 するセンサを有し、前記不活性ガス供給部及び前記不活 性ガス排気部の少なくとも一方の服動を前記センサの出 力に基づいて制御することを特徴とする。

【請求項15】 請求項13又は請求項14に記載のデ バイス製造関連装置であって、

前記位置決め機構は、前記ペリクル膜の面に平行な方向 に、前記不活性ガス供給部及び前記不活性ガス排気部の 少なくとも一方を駆動することを特徴とする。

【請求項16】 請求項10乃至請求項15のいずれか 1項に記載のデバイス製造関連装置であって、

前記不活性ガス供給部及び前記不活性ガス排気部の少な くとも一方は、前記ペリクル膜の面に直交する軸を中心 として回動可能に支持されていることを特徴とする。 【請求項17】 請求項1万至請求項15のいずれか1

項に記載のデバイス製造関連装置であって、 前記ペリクル枠の位置を検知するセンサを更に備え、 前記位置決め機構は、前記センサの出力に基づいて、前

前記位置決め機構は、前記センサの出力に基づいて、前 記ペリクル枠を所定の位置に位置決めすることを特徴と する。

【請求項18】 請求項1乃至請求項17のいずれか1 項に記載のデバイス製造関連装置であって、 前記レチクルに形成されたパターンで基板を露光する露 米銘を更に備えることを特徴とする。

【請求項19】 請求項1乃至請求項17のいずれか1 項に記載のデバイス製造関連装置であって.

前記レチクルに形成されたパターンで基板を露光する露 光装置として構成されていることを特徴とする。

【請求項20】 請求項1乃至請求項17のいずれか1 項に記載のデバイス製造関連装置であって

前記ペリクル枠内の空間であるペリクル空間内のガスを 不活性ガスで置換するガス置換装置として構成されてい ることを特徴とする。

【請求項21】 請求項1乃至請求項17のいずれか1 項に記載のデバイス製造関連装置であって、

レチクルを保管するレチクル保管庫として構成されていることを特徴とする。 【請求項22】 請求項1乃至請求項17のいずれか1

項に記載のデバイス製造関連装置であって、 レチクルを検査するレチクル検査装置として構成されて

レナブルを検査するレナブル検査装置として構成されていることを特徴とする。

【請求項23】 請求項1乃至請求項17のいずれか1 項に記載のデバイス製造関連装置であって、 レチクルを搬送するためのレチクル搬送ボックスとして

構成されていることを特徴とする。 【請求項24】 ペリクル機をペリクル枠で支持したペ リクル付きレチクルにおける前記ペリクル枠の空間で あるペリクル空間内のガスを前記ペリクル枠に設けられて が通気孔を通して不添件ガスで管地するガス層板おたれて

前記ペリクル枠を所定の位置に位置決めし、

前記ペリクル空間に不活性ガスを供給する不活性ガス供 給部が前記ペリクル枠に密着した状態で、前記不活性ガ ス供給部から前記過気孔を通して前記ペリクル空間内に 不活性ガスを使われて、

不活性ガスを供給することを特徴とする。 【請求項25】 デバイス製造方法であって、

請求項1万至請求項23のいずれか1項に記載のデバイス製造関連装置を利用しながらデバイスを製造することを特徴とする。

【請求項26】 リソグラフィ工程を経てデバイスを製造するデバイス製造方法であって、

前記リソグラフィ工程は、請求項18又は請求項19に 記載のデバイス製造関連装置を利用して基板にパターン を転写する工程を含むことを特徴とする。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、デバイス製造関連 装置、ガス置換方法及びデバイス製造方法に係り、特 に、ペリクル膜をペリクル枠で支持したペリクル付きレ チクルを収容する空間を有するデバイス製造関連装置 (例えば、露光装置、ガス置換装置、レチクル検査装置、レチクル機送ボックス等)、ペリクル枠内のペリク ル空間を不活性ガスで置換するガス置換方法、及び、デ バイス製造方法に関する。

[00021

【従来の技術】 LS1あるいは超LS1などの極限相バ クーンで形成される半導体素子の製造工程において、マ スクに場かれた回路パラーンを多光列性落さされた基板 上に繰り埋影して焼き付け形成する線り巡型影響光装置 が使用されている。半導体素子の実装密度の向上に伴い パターンのより一層の微細形が嗄求され、レジストプロ セスの発度と同時に露光装置の微細化への対応がなされ ネキャ

[0003] 露光装置の解像力を向上させる方法としては、露光波長をより知波長に変えていく方法と、投影光学系の開口数(NA)を大きくしていく方法とがある。[0004] 露光波長については、365 nmの1線から、設近では248 nm付近の発波長を有するKrFエキシマレーザの開発に移行している。更に、157 nm付近の発波長を有するス rFエキシマレーサの開発に移行している。更に、157 nm付近の発波長を有するアナスドレーサの開発と存在かれている。

【0005】 連繋外線とりわけ193 n m付近の発振波 長を有するA r F エキシマレーザや、157 n m付近の 発振波長を有するフッ素  $(F_2)$  エキシマレーザにおい ては、これら波長付近の帯域には酸素  $(O_2)$  の吸収帯 が複数存在することが知られている。

【0006】例えば、フッ素エキシマレーザーは、発振波長が157mに増いため、露光装配への応用が進められているが、157mにかり流鉄上一般に変換と一般に変換と一般に変換と呼ばれる波具原像にある。この波具側板では被素分子による光の吸収が大きいため、大気は3ほとんど光を透過、空近くまで圧力を下げ、酸素濃度を充分下げた環境でしか応用ができない。文献、「Photochemisty of Small Molecules」(Hideo Okabe著、A Wiley-IntersciencePublication、1978年、178日)にあると沙実長57mの形に対する酸素の吸収係数は約190atm<sup>-1</sup>cm<sup>-1</sup>である。これは、1気圧中で1%の酸素濃度の気体中を波長157mの光が過去すると、1cmあたりの透音率が、

 $T = e \times p \ (-190 \times 1 \text{ cm} \times 0.01 \text{ atm}) = 0.150$ 

しかないことを示す。

【0007】また、酸素が上記光を吸収することにより オゾン(O<sub>3</sub>)が生成され、このオゾンが光の吸収をよ り増加させ、透過率を著しく低下させる。これに加え、 オゾンに起因する各種生成物が光学業子表面に付着し、 光学系の効率を低下させる。

【0008】したがって、A F F エキシマレーザ、フッ 素(F<sub>2</sub>)エキシマレーザ等の遠紫外線を光源とする技 影露光装置の露光光学系の光路においては、整葉等の不 活性ガスによるパージ手段によって、光路中に存在する 酸素濃度を製 p p m オーダー以下の低レベルにおさえる 方法がとられている。

[0009] このように、遠梁外線とりわり193 nm 付近の彼長を有するArFエキシマレーザや、157 n m付近の彼長を有するArFエキシマレーザ光を利用した露光装置においては、ArFエキシマレーザ光や、フッ素(F2)エキシマレーザ光が中流に物質に吸収されたがよいめ、光路内を数ppmオーゲー以下にパージする必要がある。また、木分に対しても同様のことが言え、やはりppmオーゲー以下まで除去する必要がある。

[0010] このため、篝光装置内とりわけ紫外光の光路となる部分に関しては、不活性ガスでパージすることが行われている。また、電鉄装置内部と外部を連絡する部分には、ロードロック機構が設けられ、外部からレチクルやウエハを扱うする場合には、一旦外気と遮断し、ロードロック機構の酸紫条や水などを不活性ガスでパージレク像に電光装置内部に搬入していた。

【0011】図1は、フッ素(F2)エキシマレーザを 光源とし、ロードロック機構を有する半導体露光装置の 一例を模式的に示す図である。

【0012】図1において、1はパターンの描画された レチクルを搭載するレチクルステージ、2はレチクル上 のパターンをウエハに投影する投影光学系、3はウエハ を搭載しX、Y、Z、θおよびチルト方向に駆動するウ エハステージ、4は照明光をレチクル上に照射するため の照明光学系、5は光源からの光を照明光学系4に導光 する引き回し光学系、6は光源であるフッ素 (P2)エ キシマレーザ、7はレチクル上のパターン領域以外が照 明されないように露光光を遮光するマスキングブレー ド、8および9は各々レチクルステージ1およびウエハ ステージ3周囲の露光光軸を覆う筐体、10は投影光学 系2および照明光学系4の内部を所定のHe雰囲気に調 節するHe空調機、11および12は筐体8および9の 各々の内部を所定のN。雰囲気に調節するN。空調機、 13および14はレチクルおよびウエハを各々筐体8お よび9内に搬入する時に使用するレチクルロードロック およびウエハロードロック、15および16は各々レチ クルおよびウエハを搬送するためのレチクルハンドおよ びウエハハンド、17はレチクルの位置調節に用いるレ チクルアライメント部、18は複数のレチクルを筐体8 内で保管するレチクル保管庫、19はウエハのプリアラ イメントを行うプリアライメント部である。

【0013】必要に応じて、露光装置全体を不図示の環境チャンバに収納し、所定の温度に制御された空気を環

境チャンバ内で循環させることによりチャンバ内の温度 を一定に管理することができる。

【0014】図2は、フッ素(F<sub>2</sub>)エキシマレーザを 光源とし、ロードロック機構を有する半導体露光装置の 他の例を示す断面模式図である。

[0015] 図2の露光洗液では、蒸火洗液をかか管体 2 ので敷われてもり、その内部の0、3 あたげも、0 2 ガスによりパージされている。2 1は、筐体 2 0全体 をり、雰囲気にするための空間機である。この寒光洗液 では、鏡筒 2 に即形光学系。の内部空間は各で転さ の内部空間(駆射条空間)と隔離されており、独立に日 安那気に調節されている。1 3 および 1 4 はレチクル およびケエハを各々筐体 2 0内に難入する時に使用する レチクルロードロックおよびウエハロードロックであ る。

【0016】一般的に、レチクルにはペリクルと称され るパターン保護装置が付けられている。これはレチクル パターン面に塵埃などの異物が付着するのを防止するも のであり、これによりウエハ上への異物転写による不良 の発生類度が抑制される。

「0018] 図4は、図1放で2に示した露光装置におけるレチクルの搬送路路の一例を示す様式図である。図4 において、22は14 チクルを耐やペリクル開大のできる。図4 において、22は14 チクルを開きた計画する異物 検索装置である。レチクル23は手動または不包示の搬送装置によって賃貸装置の入口をはあるため、搬入されるレチクルとペリクルは貼り合わされるため、搬入されるレチクルとペリクルは貼り合わされるため、搬入されるレチクルとペリクルは貼り合わされるため、搬入されるレチクルとペリクルは貼り合わざれるため、搬入されるレチクルとペリクルは貼り合わざれるため、地入されるレチクルとペリクルは関いへができませます。

[0019]

【発明が解決しようとする課度】上記の通り、繋外線とりわけAFFエキシマレーザ光やファ薬(F<sub>2</sub>)エキシマレーザ光や、ファ素(F<sub>2</sub>)エキシマレーザ光や、ファ素(F<sub>2</sub>)エキシマレーザ光や、ファ素(F<sub>2</sub>)エキシマレーザ光がかて、充分な透過率と安定性を得るためには、酸素及び水分温度を低減し、これらの濃度を酸消に制御するを要が、ある、そのため、悪光装置の格とを接着にある。最大をは、ロードロック機構が設けられ、外部から露光装置内にレチクルやウエハを教気(重視し、レードロック機構が設けられば、ロードロック機構が設けられば、ロードロック機構が設けられば、ロードロック機構が設けられば、ロードロック機構が表しませば、アードロック機構が必要が、重視し、ロードロック機構が必要が、重視し、ロードロック機構が必要を必要が、できないでは、ロードロック機構が必要を必要が、できないでは、ロードロック機構が必要を必要が、できないでは、ロードロック機構が必要を必要が、またいでは、ロードロック機構が必要を必要が、できないでは、ロードロック機構が必要を必要が、できないでは、ロードロック機構が必要を必要が、ロードロック機構成がある。

[0020]しかしながら、ロードロック室に搬入される もレチクルにはベリクルが貼られており、ベリクル空間 は比較的小さな過気孔を介してのみ外気と適遇が可能な 構造であるため、ロードロック室内が所定の不活性ガス 濃度に達した後も、ベリクル空間内の覆機が完下するに はっていた。 なっていた。

【0021】ペリクル枠の過気孔に関しては、特開平6 -27643号公報、特開平9-197652号公報等 においてペリクル枠に吸戻も上げ射転孔を設ける発明が 開示さたている。しかし、孔の数や確康を増やしても、 不活性ガス雰囲気中に置いただけでは、ペリクル空間の と外部との不活性ガス過度をに超因する拡散現象が主た る置娘のメカニズムになるに過ぎず、発制的にパージを 行うロードロック変に繋がて長りで温味時間が必要。なっ ていた。また、孔の経路中に弁や除慮フィルタを配置し た場合にはさらに置接時間が長くなってしまうという欠 点があった。

【0022】特開平9-73167号公報には、あらか じめ不活性ガス雰囲気中でレチクルとペリクルを張り合 わせ、ペリクル空間内を1%酸素濃度以下の不活性ガス で封入する発明が開示されている。しかし、前述のよう に波長157nmの光の透過率は、酸素濃度1%の大気 圧気体中の場合で1cm当たり15%しかない。現状で は、レチクルとベリクル膜との間の間隔は約6mmであ り、たとえ酸素濃度0.1%の気体で充填しても、この 空隙での波長157nmの光の透過率は89.2%にし かならない。一方、露光装置の光源からウエハまでの光 路の空間総距離は少なくとも1mを越える。1mの空間 の透過率として80%以上を確保するためにはおよそ1 Oppmy/y以下に酸素濃度を抑える必要があり、理想 的には1ppm以下が目標となる。他の空間とのバラン スや総空間距離での透過率維持という観点からペリクル 空間についても少なくとも1~100ppm以下の酸素 濃度が要求される。もちろん水分や炭酸ガス濃度につい ても同様である.

【0023】また、ペリクル空間内をこれらppmオー

ダーの酸素濃度の不活性ガスで一旦封入しても、これら レチクルとペリクルが置かれる空間の酸素濃度が内部よ り高い場合には、ペリクル枠とレチクルを接着した面が 完全な気密構造でないために微細な隙間から酸素が内部 に侵入するので、%オーダーに酸素濃度を維持すること は可能であるとしても、ppmオーダーに酸素濃度を維 持することは非常に困難であった。さらに、ペリクル膜 がフッ素系樹脂の場合については、酸素透過性があるた め、ppmオーダーの酸素濃度の維持はより困難な状況 にあった。したがって、ベリクル空間内の不活性ガス濃 度が不十分な状態でレチクルステージにレチクルが搭載 され、露光作業が行われる可能性があった。この場合、 ペリクル空間内の不活性ガス濃度はレチクルステージ上 で徐々に周囲の不活性ガス濃度に近づいていくため、ペ リクル空間内での露光光の透過率が変化し、その結果、 ウエハ上で所定の露光量が安定して得られず、ウエハト に転写されるパターンの寸法変化等の不具合が発生する 可能性があった。

[0024]さらに、露光装置より外部の大気環境で保管されていたベリクル博とトチルは、ベリクル腰やベリクル特を含ま版に多くの水のゲチが着とした場合が多い。また、不活性ガス雰囲気中で保管されていた場合においても、露光装置と搬入する軽程で、外部大気環境に一旦さらされる可能性があり、やはり同様の懸念があった。

[0025] ごれらのペリクル腰等の表面に付着している水の分子の量は、その表面の倣接が立荒さそ表面性 状、特に観水性か避水性かによって大きく左右される。 さらに関脳材料においては基下ながら影晶中に水分があ 収される場合もあり、特にペリクル要や施塞フィルタに はファ素系の樹脂材料が使用される可能性も高く、多量 の水分が表面でいし内部に付着したり、吸収されたりし ている可能性がある。

【0026】この場合、ペリクル空間向を不活性ガスで 運搬しても、これを表面に件着上り、吸収されたりし ている水の分子が徐々に不活性ガス中に脱離するため、 ペリクル空間内の水分濃度を知時間でppmオーグーに ドげることは非常な理しい。また、不活性ガスの供給液 量を光かに多くして、パージを停止した時点たおいても この水分の脱離は離脱して起こっているため、泉いベリ クル空間内の水分濃度は徐々に上昇していくという不具 合があった。

【0027】このようなレチクルを使用してパターンを 露光した場合には、ペリクル空間内での露光光の造場率 が徐々に変化してしまい、その結果、ウエハ上で所定の 感光量が変定して得られず、ウエハに転写されるパター ンの寸弦変化等が発生するという不具合があった。

【0028】上記の問題点に鑑み、レチクル枠に通気孔を設け、この通気孔を通してベリクル空間内に強制的に

不活性カスを供給する方法が考えられる。しかしなが ら、この方法においては、ペリクル付きレチクルを所定 の位置に位置決めし、その後、ペリクル枠が所定位置に 存在することを前提としてペリクル枠に不活性ガス供給 部を接近させると、ペリクル枠が前記所定位置からずれ ている場合に、ペリクル枠に過度な力が加わって変形等 しうるという問題がある。

[0029]本売明は、上記の背景に鑑かてなされたものであり、ペリクル枠が下港引な位置に位置がめされることによる問題を解決すること、例えばペリクル枠に不活性ガス供給部を近接させてペリクル空間内に不活性ガスを供給部を近接させてペリクル枠の変形等を最小機に知えることを目的する。

### [0030]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の側面は、 ベリクル概をベリクル枠で支持したベリクル付きレチク ルを収容する空間を有するデバイス製造関連装置に係 り、前配ペリクル枠を所定の位置に位置決かする位置決 め機構を備えることを特徴とする。

[0031]本発明の好達な実績の形態によれば、前記ペリクル付きレチクルは、前記ペリクル特に選究孔を有し、前記ペパケンスを適用速速度は、前記過気孔を通して、前記ペリクル枠内の空間であるペリクル空間に不活性ガスを供給する不活性ガス疾給部を更に備えることが好ましい。

【0032】本発明の好適と実験の形態によれば、前記 位置決め機構は、前記不活性ガス供給部を移動させる とにより前記ペリクル枠を位置決めすることが好まし い。或いは、前記位置決め機構は、前記不活性ガス供給 部を位置決めの基準として前記ペリクル枠を位置決めす ることが好ましい。

【003】本原明の好意次集能の形態によれば、前記 不活性ガス供給部は、その先端に弾性体を育することが 好ましく、前記心置決か機構は、位置決め及び不活性ガ スの供格の際に、前記弾性体と前記ペリクル枠とを審査 させることが得ましい。こで、前記ペリクル枠の面に 直交する方向についての前記弾性体の幅が、前記ペリク ル像の面に直交する方向についての前記ペリクル枠の幅 とほぼ学しいいたがました。

[0034] 本発明の好意次実態の形態によれば、前記 位置外地機構は、位置外炎及下活性ガスの供給の際 に、前記不活性ガス供給部の先端で前記ペリク小棒を押 圧することが好ましい。ここで、前記位置沙の機構は、 前記ベリクル件を加める力を検討するとセッケを引 前記ベリクル件を締めの先端で前記ペリクル体を押圧する 方を前記とマケの出力に基づいて制御することが好まし は、また、前記位置沙の機構は、前記ペリクル像の画に 平行な方向に、前記へ選先性ガス供給部の先端で前記ペリ クル棒を押圧することが好ましい。

【0035】本発明の好適な実施の形態によれば、前記

ペリクル付きレチクルは、前記ペリクル枠に第1及び第 2の適気孔を有し、前記デバイス製造関連装置は、前記 第1の強視八差地して、前記ペリクル枠内の空間である ペリクル空間に不活性ガスを供給する不活性ガス供給部 と、前記第2の通気孔を通して、前記ペリクル空間内の ガスを掛款する不活性ガス排気部とを更に備えることが 好ましい。

【0036】本売明の好適と実施の形態によれば、前記 位置於砂機構は、前記で活性ガス株舎態及び前記で活性 水J線外総の少なくも一方を移動させることにより前 記ペリクル枠を位置決めまつることが好ましい、或いは、 前記位置決め機開は、前記で活性ガス株格部又は前記で 活性ガス株成部を位置決め基準として前記ペリクル枠を 位置決めすることが好ましい。或いは、前記位置決め機 構は、前記で活性ガス株体部及び前記で活性ガス財気部 はことって前記ペリンル枠を独立した。前記で活性ガス 株給部及び前記で活性ガス株体部の少なくとも一方を駆 動して、前記ペリクル枠を依立とが対まし い、成

【0037】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 位置決め機構は、前記ペリクル枠に加わる力を検知する センサを有し、前記不活性がス供給部及び前記不活性が 太排気部の少空くとも一方の駆動を前記センサの出力に 基づれて制御するが好ましい。

【0038】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 位置決め機構は、前記ペリクル膜の面に平行な方向に、 前記不活性ガス供給部及び前記不活性ガス排気部の少な くとも一方を駆動することが好ましい。

【0039】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 不活性ガス供給部及び前記不活性ガス排気部の少なくと も一方は、前記ペリクル膜の面に直交する軸を中心とし て回動可能に支持されていることが好ましい。

[0040] 本発明の好禮な実施の形態によれば、前記 デバイス製造限建装置は、前記ペリクル枠の位置を検知 するセンサを更に備え、前記位置決め機構は、前記セン サの出力に基づいて、前記ペリクル枠を所定の位置に位 置決めすることが好ましい。

[0041] 本発明の好適な実施の形態によれば、前記 デバス製造関連装置は、前記レチクルに形成されたパ ターンで基板を露光する露光部を更に備えることが好ま しい。

【0042】前記デバイス駆急関連装置は、前記レチクルに形成されたパターンで基板を露光する電光装置として、前記ペリクル枠内の空間であるペリクル空間内のガスを不活性ガスで置換するガス置換装距として、レチクルを検査するレチクル保管速として、レチクルを接査するレチクル機能表が入るとして、構成されるる。【0043】本発明の第2の側面は、ペリクル機をベリクル棒で支持したベリクル体で大サクトルにおける前記ペ

リクル特内の空間であるベリクル空間内のガスを歯配へ リクル特に設けされた通気孔を通して不活性ガスで置換 するガス選換力法に係り、前記ペリクル特を所定の位置 に位置決めし、前記ペリクル空間に不活性ガスを供給す る不活性ガス供給部が前記ペリクル体に容もした状態 で、前記不活性ガス供給部から前記通気孔を通して前記 ペリクル空間内に不活性ガスを供給することを特徴とす

【0044】本発明の第3の側面は、上記のデバイス製造関連装置を利用しながらデバイスを製造することを特徴セス2

[0045] 本発明の解4の側面は、リソグラフィ工程 を経てデバイスを製造するデバイス製造方法であって、 前記リグラフィ工程において、第光装置としてのデバ イス製造関連装置を利用して基板にパターンを転写する ことを特徴とする。 [0046]

[発明の実施の形態]本発明の好達な実施の形態の高光 装置は、露光光として紫外光を用いてレテクルパターン 支援が実施を入して紫外紫をに投影する露光装置に関 する。この露光装置内にペリクル枠の位置池が横橋と不 活性ガス供給部を配置して、不活性ガス供給部からペリ クル空間内に対して、ペリクル枠に設けた通気孔を通し て不活性ガスを供給する。

[0047] 一般に、レチクルにペリクル枠を接着する 接着剤は、レチクルとペリクル枠の対角砂造ルによる転 勝利の差によりレチクルパターン面が定形しないように 柔軟な接着剤を使用している。ペリクル付きレチクルを 位置決めして固定した後に、不活性ガス供給ノズルをペ リクルに押し付けると接着材に力が加わり、ペリクル枠 の変形や制能等の原況になる。

【0048】そこで、本毎期の好遊火業施の形態では、 ペリクル枠を所定位置に位置決めして、その後、ペリク ル枠に設けられた通気孔を通して不活性ガス供給部から ペリクル空間内に不活性ガスを供給する。このように正 活性ガスを供給するための所定位置にペリクル枠に落書する 位置を配置されて不活性ガス供給部からペリクル枠の通 気化を通してペリクル枠の 気化を通してペリクルを回 に、不活性ガス供給部からペリクル枠の通 気にを通してペリクルを回 に、不活性ガス供給部がら、リクル枠 とうにはペリクル 枠とレチクルとの接着部分に過度な力を加えることを防 止することができる。

【0049】ここで、ペリクル枠の位置洗砂は、ペリクル付きレチクルが移動可能を状態で、例えば不活性ガス 供格節をペリクル枠に当接させて行うことが好ましい。 この場合、ペリクル付き上チクルの位置洗めの際及パリクル リクル空間外への不活性ガスの供給の際に、ペリクル 中、さらにはペリクル枠とレチクルとの接着部分に過度 な力が加らないので、ペリクル枠の変形や刺艇等をよ り効果やに防止することができる。 【0050】また、不活性ガス供給部とペリクル体を落きせて不活性ガス供給部からリクル空間内にカリクル空間内に対している。 原者の間に帰間ができ、その表面には凹凸があると、原者の間に帰間ができ、その原間を退して不活性ガスの時間を対している。 アる性がある場合では、例えば、不派性ガス供給部が2回凸、うねり、さらにペリクル枠が個重がれた。 設けられうるフィルタの厚みやその面積度などが考えられる。 さらに、ペリクル枠が個重決がある。 位置と不活性ガス供給部の位置の調整とよっても、不活性ガス供給部とペリクル枠とを蓄着させたときに原籍の間に隙間ができ、その隙間を通して不活性ガス性

【0051】そこで、本部別の好適な実験の形態では、 不活性ガス供給部の先端に現性体を設けた、この弾性体 により不活性ガス供給部を及び、リクル枠の表面の凹凸や 両者の位置誤差が吸収され、不活性ガス供給部とペリク 材性の位置に立か吸なされ、不活性ガス供給部とペリクル 勝高きに適安する方向についての個)をペリクル枠の 最高きに噂等しくすることにより、不活性ガス供給部を リクル枠に押し付けたときの弾性体の変形による応力が 接触部分の全域にわたって暗め一になり、不活性ガス供 給離とペリクル枠の接触部の全域におたって暗め一な力 で不活性ガス供給部とペリクル枠とを密着させることが できる。

【0052】本発明の好適な実施の形態の露光装置は、 露光用の葉外光として、レーザを光源とするレーザ光、 例えば、フッ素エキシマレーザ光(波長:157 n m)、ArFエキシマレーザ光(波長:193 nm)等 を使用しうる。

【0053】また、上記の不活性ガスとしては、例えば、窒素、ヘリウム、アルゴンから選ばれる1種が好適

【0054】上記のようなペリクル枠の位置決め機構を 有するパージ機構(ガス環接装置)は、ペリクト付きレ チクルを使用するあらゆる感光装置ご適用することがで きる他、例えば、レチクル保管庫(レナクルストッカ 一)、レチクル検索装置、レチクル検送ボックス等にも 適用することができる。すなわち、本発明は、ペリクル 付きレチクルを使用し、取り扱い、又は検室等する各種 の半導体製造関連装置に適用することができる。

【0055】以下、図面を参照しながら本発明の好適な 実施の形態を説明する。

【0056】【第10天統の形態】図5及び図6は、本 発明の第1の実施の形態のバージ機構(ガス置換装置) を示す図である。図5は側面断面図、図6は下面断面図 である。このバージ機構は、ベリクル空間を不活性ガス でパージする。

【0057】図5及び図6における気密チャンバ36

は、例えば、図1のレチクル保管庫(レチクルストッカー)18若しくはそれを収納する筐体8又はレチクルロードロック13に相当しうる。また、この気密チャンバ36は、レチクル検査装置の筐体やレチクル搬送ボックス等にも相当しうる。

【0058】以下では、このパージ機構を筐体8内に設けた例、すなわち、図1に示す筐体8を気密チャンバ36とする例を説明する。

【0059】不活性ガス排給館29から気密チャンバ36内に不活性ガスが供給され、不活性ガス排出口35より不活性ガスが併出されることにより、この気感チャンバ36からそが指サオスが一ジすることができる。なが、図るが辺めでは、特別の便宜上、気密チャンバ36がいさく描かれているが、実際には、気密チャンバ36は、その中にレチクル23の図1のレチクルハンド15、レチクルスデージ1、レチクルペを襲出18巻ができれる大きさを有し、図5及び図6には示されていないが、気電チャンバ36内にほそれらが配置されているものとする。

【0060】レチクル支持台28は筐体8(気感チャン バ36)内のレチクル搬送経路内に配置され、ペリクル 24が貼り付けられたレチクル(ペリクル付きとサール)23は、レチクルハンド15(図1参照)あるいは 気高チャンバ36外に設けられた不恒の搬送也ボット によって、又は、手動によって支持台28上の貯貨の位置に、移動可能な状態で裁置される。ペリクル24のペ リクル枠25には図13に示すように複数の通気孔27 が予設設けられている。

【0061】気感サャンパ36の中には、ペリクル枠2 5の13匹は対して所定の間隔を設けて、不活性がス供給 第29(この実験の形態では、供給ノスル) 皮び供給部 駆動機構30が配置されている。また、ペリクル24を 採れて不活性と供給第20数代給部駆動機構30に 対向する位置には、不活性ガス排気部57(この実施の 形態では、排気、メル) 及び排気部駆動機構30が配置 されている。

【0062】供給經算動機関30は、不活性ガス供給部 29を沙なくとも1方向に罪動させるための案件(イド)とアクチュエータを有する。供給部原動機関30級 び排充施配動機関37級、ペリクル24のペリシル枠2 5を挟み込むように、不活性ガス供給部29級で不活性 ガス排水部37を駆動する。これにより、ペリクル枠2 5の過氧71.27に対して不活性ガス供給部29級で不活性 性ガス排水部37がそれぞれ密着するように、ペリクル 枠25、不活性ガス供給部29、不活性ガス排水部37 を相約的に位置が少まくたができる。

【0063】このようにベリクル枠25を位置決めの対象とすることにより、ベリクル空間内のパージ後にレチクルハンド15がベリクル付きレチクル23をレチクルステージ1等に搬送する際に、ベリクル枠25とレチク

ルハンド15とが干渉することを防止することができ 2

【0064】さらに、ペリクル枠25の位置を検知する センサ50を設け、センサ50の出力に基づいて、ペリ クル24件きレチクル23を設践するレチクルルンド1 5を制御することが好ましい。これにより、例えば、レ チクルハンドにより支持台28上にペリクル付きレチク ル23を裁置する際にペリクル枠25を方支持台28と干 渉することを防止することができる。センサ50は、例 えばCCDカメラ等の提像装置によりペリクル枠25を 提像してその位置を検出するとンサであってもよいし、 レーザ光等によりペリクル枠25を サ (例ば、レーザ測美術)であってもよいし、他の方 式のセンサであってもよいし、他の方 式のセンサであってもよいし、他の方 式のセンサであってもよいし、他の方

【0065】一般に、レチクルにペリクル枠を接着する 接着剤としては、レチクルとペリクル枠の材質の違いに よる熱膨張の差によりレチクルパターン面が変形しない ように、柔軟な接着剤が使用されている。 レチクル23 を位置決めして固定した後に不活性ガス供給部29や不 活性ガス排気部37をペリクル枠25に押し付けると、 接着材に過度な力が加わり、ペリクル枠の変形や剥離等 の原因になる。この実施の形態では、レチクル23が自 由な状態でペリクル枠25を所定の位置に位置決めする ので、レチクル23とペリクル枠25との接着部分に過 度な力が加わることがない。よって、ペリクル枠25の 変形や剥離等を防止することができる。不活性ガス供給 部29及び不活性ガス排気部37によってペリクル枠2 5を位置決めした後、すなわち、ペリクル枠25に不活 性ガス供給部29および不活性ガス排気部37の各先端 を密着させた後、不活性ガス供給部29からペリクル空 間へ不活性ガスを供給し、不活性ガス排気部37よりペ リクル空間内の雰囲気を排気することによってペリクル 空間をパージする。さらに、パージが終了した後にレチ クル付きペリクルは、レチクルハンド15によりレチク ルステージ1等へ搬送される。

【0066】次に、図5及び図6を参照しながらベリクル空間冷を不活性ガスでバージする工程を説明する。ま、ボ、ベリクル2 4 が貼られたレチクル2 3 がレチクルルド15を搬送ロボットあるいは手動によって、レチクル支持628上の所定の位置は、移動可能な法院で載置される、不活性ガス供給部29及び不活性ガス供給部29及び不活性ガス供給部27年で、100万億元、100万円、100万

に不活性ガスが吹き込まれる。吹き込まれた不活性ガス は、ベリクル空間内に存在する酸素や水分や他の不軽物 と混合し合いながら、ベリクル枠25に設けられた通気 孔27から不活性ガス排気部37を通って外部に押し出 される。

【0068】 [第2の実施の形態] 以下、本発明の第2 の実施の形態を説明する。なお、ここで特に言及しない 事項は第1の実施の形態に従うものとする。

【0069】図7及が図8は、未発明の第2の実験の形 聴のパージ機構を構式的に示す図である。図7は側面前 面図、図8は下前前面図である。この実験の形態の1つ の特徴は、不活性ガス集体部29及び不活性ガオ壊気部 37をそれぞれ回転輸31により回動自在に配置した点 である。図5及び個6に示す第1の実験の形態では、供 給部29及が排気部37の売場(ペリタル接触面)がペ リクル25に対して平行に開整されなければ、ペリクル 仲25を挟み込んだときに関値が発生する。これに対し て、この実施の形態では、供給部29及が排気部37の ペリクル接触面がベリクル枠25に平行であるように供 給部29及び頻素部37を回転輪31を中心にして回動 させることができるので、供給部29及び頻素部37の 構造な顕整を行わなくても上記のような瞬間は発生しない。

【0070】[第3の実施の形態]以下、本発明の第3 の実施の形態を説明する。なお、ここで特に言及しない 事項は第1の実施の形態に従うものとする。

【0071】図9及び図10は、本発明の第3の実施の 形態のバージ機構を模式的に示す図である。図9は側面 断面図、図10は下面断面図である。この実施の形態の 1つの特徴は、不活性ガス供給部29の先端(ペリクル 接触面)を位置決め基準としてベリクル枠25を位置決 めする点である。

【0072】不活性ガス供給部(この実施の形限では、 供給ノスル)29および供給部原動機構30に対して、 リカル24を採入で反対側に、不造性力ス排突部(この 実施の形態では、ペリクル枠を押圧する押圧機構33を記 されている。供給配駆動機構33が記 されている。供給配駆動機制20が円候和距距機構 31は、それぞれ不活性ガス供給部29及び不活性ガス排 気部32を少なくとも1万向に移動させるためか案内 (ガイド)とアクナュエータを有する。供給部駆動機構 30は、排気部駆動機構33よりも強い力で不活性ガス 供給部29を削進させてペリクル枠25を基準位置に位 電決わする。

【0073】この実施の形態では、供給部駆験機構30 はが本(不図示)有し、該バネの力により不活性ガス供 給部29を押圧する。また、反対側の排気部駆験機構3 3は、排気部駆動機構30よりも弱いがネ(不図示)を 有し、該バネの力により下活性ガス解炎部32を押圧す あ、よって、不活性ガス解炎第32を別ソル棒2 5に力が加わっても不活性ガス供給部29の位置がずれることはなく、不活性ガス供給部29はペリクル枠25を位置決めする基準となる。

【00741以上のように、この実施の形態によれば、不活性ガス供給密29の先端を基準として、通気孔27 が設けられた部分のペリクル枠25に対して不活性ガス 供給館29の先端および不活性ガス朝気部32の先端が 密着するように、ペリクル枠24を位置決めり付象と することにより、ペリクル空間内のパージ後にレチクル ハンド15がペリクル位との付きレチクル24をレチクル ステージ1等を顕著する際に、ペリクル枠25とレクレ ルンド15とが干渉することを防止することができ

【0075】さんに、ペリクル枠25の位置を検知する センサ50を設け、センサ50の出力に差がいて、ペリ クル24付きレチクル23を設まするレチクルハンド1 5を制御することが好ましい。これにより、例えば、レ ナクルハンドにより支持台28上にペリクル付きレチク ル23を設置する際にペリクル枠25万支持台28と干 渉することを防止することができる。

【0076】この実験の形態では、供給部駆動機構30 に設けたパネのパネ定数を持欠部駆動機構33に設けた パネのパネ定数よりも十分に大きくすることにより、不 活性ガス候格部20側を基準としてペリフル枠24の位 置合わせを行っている。しかしながら、これは本発明の 1つの実施形式に過ぎず、例えば、供給部駆動機構30 に設けたパネのパネ定数を排気部駆動機構33に設けた パネのパネ定数よりも十分に小さくすることにより、ガ 水料疾部32脚を選後としてペリフル枠24の位置合か せを行ってもよいし、不活性ガス供給部29をガス排気 部に置き換え、不活性ガス供給部29をガス排気給ご置 を検えてもよいし、不活性ガス供給部29をガス排気

【0077】また、上記の実験の形態では、バネにより、 ベリクル物2 人生材に 7押圧力を与えているが、例2 ベリクル物2 人生材1 七押圧力を参設け、該センサの 出力に基づいて駆動機構3 の及び3 3 を制御することに、 よりベリクル件2 4 に対する方で上を制御してもとした。 はりでは、10073 3 不死性ガス排象が3 2 は、回転軸3 8 を中心として回動自在に取り付けられている。不活性ガス排 気部3 2 の先端(ベリクル接触部)にはベアリング3 9 が取り付けられてより、ベアリング3 9の外輪には円環 状の側路4 0 が取り付けられている。この間略4 0 に 接触による発慮の少ない材料から選択されるものであり、PERK、PES、ボリアセタール、フッ素制脂で作られ ることが望ましい。

【0079】図9及び図10を参照しながらペリクル空間内に不活性ガスをパージする工程を説明する。まず、 ペリクル24が貼られたレチクル23がレチクルハンド 15や搬送ロボットあるいは手動によって、レチクル支 持台28上の所定の位置に、移動可能な状態で截置される。不活性ガス接給第29は、所定の位置で特徴しており、ペリクル付きトチクル23対しナチンを対ちと、置かれた後、歳いは置かれると同時に、駆動機構30によって不活性ガス供給都29がベリクル枠25の位置決めませる。

【0080】次に、不活性ガス排気部32が駆動機構3 3によりペリクル24側へ移動し、ペリクル枠25を位 置決め基準としての不活性ガス供給部29に押し付け る。この押し付けのとき、ペリクル付きレチクル23 は、不活性ガス供給部29に最初に接触した占を支占と して回転しながら不活性ガス供給部29の全域と接触す るので、不活性ガス供給部29とペリクル枠25とが摺 動することによる発塵は発生しない。また、ベリクル枠 25と不活性ガス排気部32との接触部もベアリング3 9が僅かな転がり運動を行いながら押し付けを行うの で、摺動による発應がペリクル枠25及びペリクル26 表面に付着してデバイスの共通欠陥を引き起こすことは ない、このように不活性ガス供給部29の先端とペリク ル枠25とが指動しない構成を採用することにより、図 11のように不活性ガス供給部29の先端に摩擦の大き い弾性体41を配置することができる。ここで、不活性 ガス供給部29の先端に弾性体41を配置することによ り、ペリクル枠25を確実に押し付けることができる。 【0081】ペリクル枠25に対して不活性ガス供給部 29及び不活性ガス排気部33を密着させた後、不図示 の不活性ガス供給装置から不活性ガスが不活性ガス供給 部29に供給され、ペリクル枠25に設けられた通気孔 27を通してペリクル空間内に不活性ガスが吹き込まれ る。吹き込まれた不活性ガスは、ペリクル空間内に存在 する酸素や水分や他の不純物と混合し合いながら、ベリ クル棒25に設けられた浦気孔27浦って不活性ガス排 気部33の上方及び下方に押し出される。

【0082】このように不活性ガス供給部29を位置決め基準として、これにペリクル枠25を押し付けることにより、清浄かつ確実な押し付けが実現される。

【0083】この実施の形態においても、不活性ガス供給部29をガス排気部に置き換え、不活性ガス排気部3 2をガス供給部に置き換えることができる。

【0084】 [共通事項] 以下、上記の第1〜第3の実施の形態に共通に適用可能な構成を説明する。

【0085】不活性ガス供給器29とベリクル枠25と を需省させてベリクル空間内に不活性ガスを保給すると きの不活性ガスの織九防止について限明する。図11は ガス供給第29の先端に弾性体41を配置した構成を示 対戦略図である。不活性ガス供給第29の先端には弾性 体41が固定されている。また、ベリタル枠25に設け られた通気孔27には防塵のためのフィルタ42が貼り 付けられている。弾性体41はレチクル23下面との間 に優かを関節が続きわるように記憶され、弾性体41 の高さ (ベリクル膜26の面に直交する方向についての 幅) は、例えばベリクル枠25の高さとほぼ同じであ \*\*\*

【0086】一般に、不活性ガス供給部29及びベリクル棒25の表面には凹凸があり、互いを審蓄させた時に 瞬間ができて不活性ガスの漏れが発生する場合がある。 凹凸の原因は、不活性ガス保持部29及びベリクル棒2 5の機械加工による表面の細かな凹凸、うねり、さらに ベリクル棒25の週末27に貼られたフィルタ42の 厚みやその面積度などである。

【0087】そこで、不活性ガス供給部29の先端に弾 性体41を取り付けることが好ましい。これにより、不 活性ガス供給部29の先端とベリクル枠25の表面の凹 凸や位置誤差などを吸収して、不活性ガス供給部29の 先端とペリクル枠25との接触面全域に渡って略均一な 力で両者を密着させることができるので、不活性ガスの 漏れを効果的に低減することができる。この弾性体41 としては、例えばゴム硬度が60以下のゴムやスポンジ などから選択されるフッ素ゴムやフッ素ゴムスポンジな どが望ましい。また、不活性ガス供給部29と弾性体4 1との接着には、有機質の少ない接着材を選択すべきで あり、例えば加硫接着や焼き付け接着などが望ましい。 【0088】図12は、ペリクル枠25の高さペリクル 膜26の面に直交する方向についての幅) より高い高さ を有する弾性体41を押し付けて変形させた状態を表す 概要図である。ペリクル枠25の下端の部分が弾性体4 1にめり込み、弾性体41を大きく変形させている。こ のとき、弾性体41の変形による応力が高さ方向(ペリ クル膜26の面に直交する方向) において不均一にか り、ペリクル枠25の下端の部分、すなわち、ペリクル 枠25が弾性体41にめり込んでいる部分において広力 が最大になる。よって、弾性体41の高さ方向(ペリク ル膜26の面に直交する方向)の全域における平均の変 形量は図11の場合に比べて小さくなり、押し付け不足 によって不活性ガスの漏れが発生し易くなる。また、ペ リクル枠25の下端の集中応力によりペリクルが持ち上 げられたり不活性ガス供給部29が変形を起こしたりす る可能性があり、ペリクル枠25と不活性ガス供給部2 9の先端の接触部からの不活性ガスの漏れが発生し易く なる。

【0089】一方、図11に示すように、弾性体41の 高さをペリクル枠25の高さと略同じ高さとすることに より、不活性ガス供給部29をペリクル枠25に押し付 けたとの弾性体41の変形による広力が略均一にな り、不活性ガス供給部29の先端とペリクル枠25との 接触面とが全域にわたって限め一な力で巻きおん。 【0090】さらに、不活性ガス供給部29(及び不活 性ガメ財疾部37)がペリクル枠25に対して適度な力 を加えることを助止するために、不活性ガス供給部29 (及び不活性ガス排疾部37)がペリクル枠25に対して適度な力 ている力を検知する圧力センサ(例えば、圧電素子)2 9 aを設け、圧力センサ29 aの出力に基づいて駆動機 構30を制御することが好ましい。

【0091】上記の各実施の形態では、不活性ガス供給 部及び不活性ガス排気部の双方を移動させて、それらを ペリクル枠に密着させるが、不活性ガス供給部及び不活 件ガス排気部のいずれか一方のみを移動させてもよい。 【0092】上記の各実施の形態では、ペリクルと位置 決め機構としての不活性ガス供給部及び排気部とを接触 させてペリクルの位置決めを行うが、例えば、不活性ガ スを吹き付ける力や磁力などを利用して非接触でペリク ルの位置決めを行ってもよい。例えば、レチクルに対し てその下方向から不活性ガスを吹き付けて、レチクルを 浮上させた状態で、光電センサ、CCD、超音波センサな どにより非接触でペリクルの位置を測定して、ペリクル に対してその横方向からさらに不活性ガスを吹き付ける ことによりペリクルの水平方向を非接触で位置決めする ことができる。ここで、ペリクルに対してその横方向か らさらに不活性ガスを吹き付ける代わりに磁石を使用し て非接触の位置決めを行ってもよい。位置決め後、不活 性ガス供給ノズルをペリクル枠の通気孔の近傍に近づけ て不活性ガスを供給することにより非接触でパージを行 うことができる。

【0093】また、上記の各実施の形態では、本発明に 係るペリクル空間内パージ機構を半導体露光装置内に配 置しているが、本発明に係るベリクル空間内パージ機構 は半導体露光装置以外に配置してもよく、例えばデバイ スメーカーのクリーンルームにおいてレチクルを保管す るレチクルストッカーやレチクル検査装置、クリーンル 一ム内においてレチクルを撤送するレチクル翻送ボック ス内に配置してもよい。ここで、不活性ガス供給部とペ リクル枠とをその接触面全域にわたって略均一を力で密 着させることにより、ペリクル枠の変形や剥離等を防止 しつつペリクル空間内に不活性ガスを充填することが出 来る。これにより、レチクルストッカーやレチクル検査 装置、レチクル搬送ボックス等から電光装置内にペリク ル付きレチクルを搬送した場合において、露光装置内で ベリクル空間をパージするための時間を短縮することが でき、生産性が向上する。さらに、レチクルパターン面 を常に不活性ガス雰囲気に維持することにより、有機 物、水分などによる汚染を防止することができる。 【0094】「デバイス製造方法]次に上記の銭光装置

を利用した半導体デバイスの製造プロセスを説明する。 図14は半導体デバイスの全体的な製造プロセスのフロ ーを示す。ステップ1(回路設計)では半導体デバイス の回路設計を行なう。ステップ2(マスク作製)では設 計した同路パターンに基づいてマスクを作製する。一 方、ステップ3(ウエハ製造)ではシリコン等の材料を 用いてウエハを製造する。ステップ4 (ウエハブロセ ス) は前工程と呼ばれ、上記のマスクとウエハを用い

て、リソグラフィ技術によってウエハトに実際の回路を 形成する。次のステップ5(組み立て)は後工程と呼ば れ、ステップ4によって作製されたウエハを用いて半導 体チップ化する工程であり、アッセンブリ工程 (ダイシ ング、ボンディング)、パッケージング工程(チップ封 入)等の組立て工程を含む。ステップ6(検査)ではス テップ5で作製された半導体デバイスの動作確認テス ト、耐久性テスト等の検査を行なう。こうした工程を経

て半導体デバイスが完成し、これを出荷(ステップ7) する。

【0095】図15は上記ウエハプロセスの詳細なフロ ーを示す。ステップ11 (酸化)ではウエハの表面を酸化 させる。ステップ12 (CVD) ではウエハ表面に絶縁膜 を成膜する。ステップ13(電極形成)ではウエハ上に電 極を蒸着によって形成する。ステップ14(イオン打込 み)ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ15(レジ スト処理)ではウエハに感光剤を塗布する。ステップ16 (露光)では上記の露光装置によって回路パターンをウ エハに転写する。ステップ17 (現像) では露光したウエ ハを現像する。ステップ18 (エッチング) では現像した レジスト像以外の部分を削り取る。ステップ19(レジス ト剥離)ではエッチングが済んで不要となったレジスト を取り除く、これらのステップを繰り返し行なうことに よって、ウエハトに多重に同路パターンを形成する。 【0096】本発明の好適な実施の形態によれば、フッ 素エキシマレーザなどの紫外光を光源とする投影露光装 置において、装置内へ搬入されたペリクル付きレチクル のペリクル空間内の不活性ガスパージを短時間に効率よ く行うことが可能となる。これにより、露光装置の生産 性を掲なうことなく、高精度かつ安定した露光制御が可 能になり、微細な回路パターンが安定してかつ良好に投

【0097】さらに、ペリクル付きレチクルが移動可能 な状態でペリクル枠を不活性ガス供給用の所定の位置に 位置決めし、その後、ペリクル枠に密着する位置に配置 された不活性ガス供給部からペリクル枠に設けられた涌 気孔を通してペリクル空間内に不活性ガスを供給するこ とにより、パージに際してのペリクル枠の変形等を助止 することができる。

[0098] 【発明の効果】本発明によれば、ペリクル枠が不適切な 位置に位置決めされることによる問題を解決することが できる。

【0099】より具体的な例を挙げると、本発明によれ ば、例えば、ペリクル枠に不活性ガス供給部を密着させ てペリクル空間内に不活性ガスを供給する際におけるペ リクル枠の変形等を最小脚に抑えることができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用されうる投影露光装置の概略構成 を示す団である。

【図2】本発明が適用されうる他の投影露光装置の概略 構成を示す図である。

【図3】ペリクル付きレチクルの概略構成を示す図であ る。

【図4】本発明が適用されうる投影露光装置のレチクル 搬送経路の概略構成を示す図である。

【図5】本発明の第1の実施の形態のパージ機構の側面 断面図である。

【図6】本発明の第1の実施の形態のバージ機構の下面 断面図である。

【図7】本発明の第2の実施の形態のパージ機構の側面 断面図である。

【図8】本発明の第2の実施の形態のパージ機構の下面 断面図である。

【図9】本発明の第3の実施の形態のパージ機構の側面 断面図である。 【図10】本発明の第3の実施の形態のパージ機構の下

面断面図である。 【図11】ノズル先端に弾件体を配置した概略図であ

【図12】ペリクル枠と上下方向の幅が異なる弾性体を

ベリクル枠に押し付けて変形させた状態を表す概要図で ある。

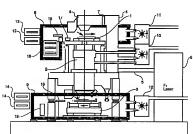
【図13】ペリクル付きレチクルの概略構成を示す図で

ある。

【図14】半導体デバイスの製造フローを示す図である。 【図15】半導体デバイスの製造フローを示す図であ

る。 【符号の説明】

1:レチクルステージ、2:鏡筒、3:ウエハステー ジ、4:照明光学系、5:引き回し光学系、6:Foレ ーザ部、7:マスキングブレード、8、9、20:筐 体、10,11,12,21;空調機、13;レチクル ロードロック、14:ウエハロードロック、15:レチ クルハンド、16:ウエハハンド、17:レチクルアラ イメントマーク、18:レチクル保管庫、19:プリア ライメント部、22:ペリクル検査装置、23:レチク ル. 24:ペリクル. 25:ペリクル枠. 26:ペリク ル膜、27:通気孔、28:レチクル支持台、29:不 活性ガス供給部、30:供給部駆動機構、31:回転 軸、32:不活性ガス排気部、29a:圧力センサ、3 3:排気部駆動機構、34:不活性ガス供給ライン、3 5: 不活性ガス排出ライン、36: 気密チャンバ(また はロードロック室)、37:不活性ガス排気部、38: 回転軸、39:ベアリング、40:樹脂、41:弾性 体、42:フィルタ、50:センサ



【図1】

